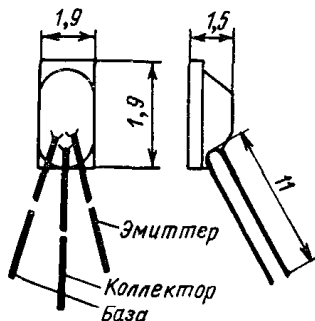


## 2Т629А-2, КТ629А

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* переключа-  
чательные

Предназначены для работы в быстродействующих импульсных  
схемах герметизированной аппаратуры

Бескорпусные на керамической  
подложке с защитным покрытием,  
с гибкими выводами Выпускаются  
в сопроводительной таре Обозначе-  
ние типа приводится на этикетке  
Масса транзистора не более 0,02 г



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с  
общим эмиттером

2Т629А-2 при  $U_{КБ} = 1,2$  В,  $I_Э = 500$  мА

при  $T = 298$  К . . . . . 25–80

при  $T = 398$  К . . . . . 25–150

при  $T = 213$  К . . . . . 10–80

КТ629А при  $U_{КБ} = 5$  В,  $I_Э = 500$  мА,  $T = 298$  К . . . 25–150

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при  $I_К =$   
 $= 500$  мА,  $I_Б = 50$  мА не более

2Т629А-2 . . . . . 0,8 В

КТ629А . . . . . 1 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при  $I_К = 500$  мА,  
 $I_Б = 50$  мА не более

2Т629А . . . . . 1,5 В

КТ629А . . . . . 1,2 В

Время рассасывания при  $I_К = 500$  мА,  $I_Б = 50$  мА, 2Т629А-2  
не более . . . . . 90 нс

Обратный ток коллектора при  $U_{КБ} = 50$  В,  $T = 213 -$   
 $- 398$  К не более . . . . . 5 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер при  $U_{КЭ} = 50$  В,  
 $R_{ЭБ} = 1$  кОм не более . . . . . 5 мкА

Обратный ток эмиттера при  $U_{ЭБ} = 4,5$  В не более . . . 5 мкА

Граничное напряжение при  $I_Э = 10$  мА не менее

2Т629А-2 . . . . . 50 В

КТ629А . . . . . 40 В

Модуль коэффициента передачи тока при  $U_{КЭ} = 5$  В,  
 $I_К = 50$  мА,  $f = 100$  МГц не менее . . . . . 2,5

Материал взят из источника:

Емкость коллекторного перехода при  $U_{КБ} = 10$  В не более:

2Т629А-2 . . . . .	20 пФ
КТ629А . . . . .	25 пФ

Емкость эмиттерного перехода при  $U_{ЭБ} = 0,5$  В не более:

2Т629А-2 . . . . .	100 пФ
КТ629А . . . . .	120 пФ

Постоянная времени цепи обратной связи\* при  $U_{КБ} = 10$  В,  $I_Э = 50$  мА,  $f = 30$  МГц

типовое значение . . . . .	120 нс
----------------------------	--------

Время выключения\* при  $I_К = 500$  мА,  $I_Б = 50$  мА, типовое значение . . . . .

75 нс

Время включения\* при  $I_К = 500$  мА,  $I_Б = 50$  мА, типовое значение . . . . .

30 нс

**Предельные эксплуатационные данные**

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при  $R_{ЭБ} = 1$  кОм . . . . .

50 В

Постоянное напряжение коллектор-база . . . . .

50 В

Постоянное напряжение эмиттер-база . . . . .

4,5 В

Постоянный ток коллектора . . . . .

1 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора

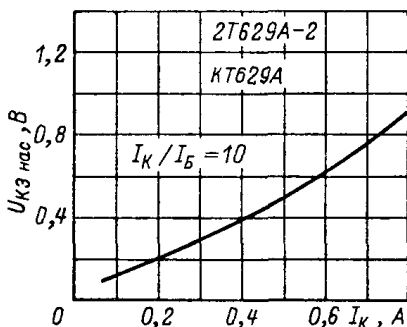
при  $T \leq 353$  К . . . . . 1 Вт

при  $T = 398$  К . . . . . 0,18 Вт

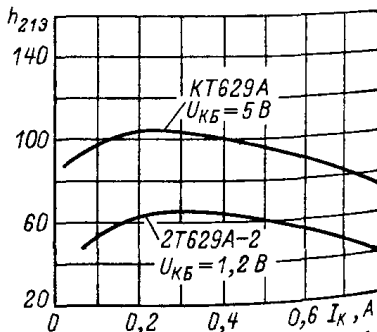
Температура перехода . . . . . 408 К

Температура окружающей среды . . . . . От 213 до  $T = 398$  К

Примечание При монтаже транзистора допускается пайка выводов на расстоянии не менее 2 мм до места выхода вывода из защитного покрытия при температуре не выше 473 К в течение не более 10 с Изгиб вывода допускается на расстоянии не менее 0,5 мм от места выхода вывода из защитного покрытия Запрещается соприкосновение вывода и кристалла и перегиб выводов на ребрах металлической подложки и на инструменте с острыми краями

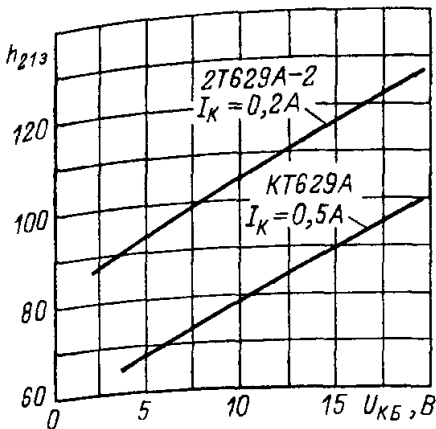


Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора

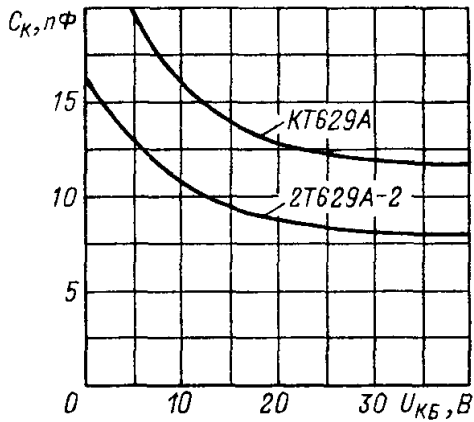


Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора.

Материал взят из источника:

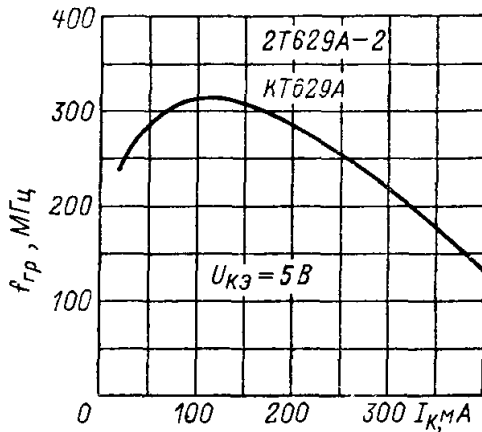


Зависимость статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-база



Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база.

Зависимость граничной частоты от тока коллектора



Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)  
Энергоатомиздат, 1985